⑲ 日本菌特許庁(JP)

昭64-6963 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)1月11日

G 03 G 5/14

103

E-7381-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

電子写真感光体 49発明の名称

顧 昭62-103312 到特

頭 昭62(1987) 4月28日 Ø₩.

發昭61(1986)11月28日發日本(JP)動特願 昭61-281914 優先権主張

大 ⑫発 明 者 節 砂発 明 九 反 関 者 砂発 明 者 小 身 人 由紀雄 砂発 明 并手 者 . 宏 ⑫発 明 囯 者 永 伸 二 個発 明 納所 者 株式会社リコー ①出 頭 人 弁理士 小松 秀岳 砂代 理 人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

外1名

明細鹽

1. 発明の名称

電子写真感光体

2. 特許請求の範囲

導電性支持体に光導電層、中間磨及び、保護 潞を順次積層した電子写真感光体において、中 間履がシリルイソシアネート化合物の分解生成 物であることを特徴とする電子写真感光体。

3. 発明の詳細な説明

「技術分野]

本発明は電子写真感光体、更に詳じくは光導 寇閻の表面に保護履を有する電子写輿感光体の 改良に関する。

[從来技術]

帯電、露光、現像、転写、クリーニングのプ ロセスを有する電子写真方式に用いられる感光 体としては多くのものが実用化されている。

例えば無機材料においてはSe及びSe-Te合金、Se-AS合金など競替膜があげら れる。一方、有機材料においてはアゾ原料、シ

アニン餌料及びフタロシアニン餌料などの有機 餌料を有機パインダー中に分散した電荷発生質 上にトリフェニルアミン系、あるいはヒドラゾ ン系電荷移動剤を含有した電荷移動窟を設けた 積層型感光体などが用いられている。これらの **感光体に対して長時間高面質を保つ信頼性の要** 求が年々苔まっている。

これらの感光体では、光導電腦が露出してい る場合、本来の特性上の寿命以前に帯電過程の コロナ放铟によるダメージと、複写プロセスで 受ける他部材との接触による物理的あるいは化 学的なダメージにより、コピー上に画像欠陥が 生じ寿命を大きく縮めてしまうことが問題にな っている。又、磁光励表面が露出していること により、感光体の表面性とトナーの性質の不適 合のためのクリーニング不良の充生や、特に有 機感光体に関して感光層が有機物で構成されて いることによる長期使用時の摩耗の発生も改善 すべき重要な課題になっている。

このような欠点を解消する方法として感光体

表面に保護層を設ける技術が知られている。具体的には、感光層の表面に有機フィルムを設ける方法(特公昭38-15446)、無機酸化物を設ける方法(特公昭43-14517)、接着層を設けた後絶縁層を積層する方法(特公昭43-27591)、或いはプラズマCVD法、光CVD法等によって、a-SI層、a-SI:N:H層、a-SI:O:H層等を積層する方法(特開昭57-179859、特開昭59-58437)が開示されている。

しかしながら保護圏が電子写真的に髙抵抗 (10 ^M Ω・CB以上)になると、残留電位の増大、 繰り返し時の得席等が問題となり実用上好まし くない。

上記欠点を補う技術として保護層を光導電腦とする方法(特公昭48-38427、特公昭43-16 198、特公昭49-10259、USP-2901348)、保護中に色素やルイス酸に代表される移動剤を添加する方法(特公昭44-834、特開昭53-13 3444)、或いは金属や金属酸化物微粒子の添加により保護層の抵抗を制御する方法(特開昭53

たもので、導電性支持体に光線電圏、中間圏及び、保護圏を顧次積圏した電子写真感光体において、中間圏がシリルイソシアネート化合物の分解生成物であることを特徴とする電子写真感光体である。

本発明の留子写真感光体の構成を第1図に示すと、1は透明保護圏で例えば酸化スズ微粒子を分散した有機高分子化合物からなるものであり、2はシリルイソシアネート化合物の分解生成物からなる中間層、3は光導電圏、4は導電性支持体である。

この中間層に用いるシリルイソシアネート化合物としては、Rを宮能基として一般的に次の様なものがある。

アルキルシリルイソシアネート型

R n S I (N C O)_{4-n} とその縮合物 アルコキシシランイソシアネート型

(RO)_n Si(NCO)_{4-n} とその糖合物

テトライソシアネート型

- 3338) 等が提案されている。

しかし、このような場合には保護層による光の吸収が生じ、感光層へ到達する光量が減少するため、結果として感光体の感度が低下するという問題が生じる(所謂フィルター効果)。

また、特開昭57-30846 に提案されているように平均粒径 0.3 μm 以下の金属酸化物を抵抗 制御剤として保護圏中に分敗させることにより、 可視光に対し実質的に適明とする方法もあるが、 実際には 0.3 μm 以上の粒子も多く存在するため、可視光の吸収、散乱が生じ、感光体の感度 が低下するという欠点を持つ。

[目的]

本発明は感光層上に表面保設層を有する感光体であって、上記欠点を解消した機械的寿命の長い高耐久性の感光体であり、又、残留電位の低い、くり返しコピーによる残留電位上昇のない感光体を提供することを目的とする。

[機成]

木発明は、上記目的を達成するためになされ

SI(NCO)」とその組合物 ただし、上記において、n = 1~3 である。 またRの異体的な官能基としては下記のもの が例示できる。

炭化水素菓:メチル基、エチル基、アチル基、 オクチル基、オクタデシル基、フェニル基、ペンジル基など

不 飽 和 基:ピニル基、アクリル基、アリル 基、メタクリル基など

アルコキシ基:エトキシ基、プロポキシ基、フェノキシ基など異体的な化合物と しては下記のものが例示できる。

トリメチルシリルイソシアネート ジメチルシリルイソシアネート メチルシリルイソシアネート ビニルシリルイソシアネート フェニルシリルイソシアネート テトライソシアネートシラン エトキシシラントリイソシアネート シリルイソシアネート化合物は上配の如く SI-NCO結合をもつもので、下記の如く、 湿気分解反応でケイ茶酸化膜を形成する。

- -Si-NCO+2H2O
- \rightarrow S i OH + NH 3 + CO 2
 - -SI-OH+-SI-OH
- $\rightarrow [Si-0-Si]_n$

したがって、Si-NCO結合をもつ化合物を基本成分として、ケイ素酸化膜形成剤ができる。必要に応じてアルギルシリケート、有機ポリマー、無機ポリマーも利用できる。又、チタン、ジルコニウム、スズ、アルミニウム、アンチモン等を加えて、メタロシロキサン結合を形成することもできる。

本発明はかかるシリルイソシアネート化合物の性質を利用して、すぐれた特性をもつ中間節が形成されることを見出してなされたものである。

これらの化合物は単独でも2種以上の混合物としても用いることができる。又、接着性改善のため、上記シリルイソシアネート化合物と他

光圀はAS、Se以外にハロゲン、Te、Sb、Bi等の緑加物の1種又は2種以上の元素を含有しても良い。感光圀の形成法としてはAS、Seが上記の条件を満足する量の合金を作製して蒸着するか、複数の蒸発源に材料単体あるいは合金を入れて共築着すれば良い。

本発明にかかわる保護器としては有機高分子化合物に有機化合物又は無機化合物などの導電制御制を適当最添加したものが用いられる。具体的には有機化合物としてはメタロセン化合物など、無機化合物としては金、銀、網、ニッケル、アルミニウムの粉末、酸化亜鉛、酸化テタン、酸化スズ、酸化インジウム、含有酸化スズなどが挙げられる。

表面保護層の比抵抗としては $1 \times 10^{\circ}$ ~ $1 \times 10^{\circ}$ Ω cnであり、好ましくは $1 \times 10^{\circ}$ ~ $1 \times 10^{\circ}$ Ω cn た 数では画像ボケが生じ、 $1 \times 10^{\circ}$ Ω cn を超えると地肌汚れが生じ、この傾向は表面保護層の膜厚が

の有機化合物との混合物及び必要ならば放媒を 加えて用いることもできる。

中間図の膜厚は任意に設定されるが、10 μ以下、好ましくは 1 μ以下、特に 0.5 μ以下が好適である。中間圏の形成は授責法、スプレー法、気相法などの方法により成膜することができる。

本発明の感光体の光謝電層としてはSe、SeーTe合金、SeーAs合金の真空蒸替膜、ZnO、CdS、結晶Se粒子などの無機光導電体を有機パインダーに分解した感光隔を有する感光体、及びこれらの積塵型の感光体、ポリビニルカルパゾール/2,4,7ートリニトロー9ーフルオレノン(PVK/TNF)等の有機感光体:又、調フタロシアニンを電荷発生菌として電荷移動隔を積層した積層型感光体を挙げることができる。

特に上記において、Se-ASを主体とする 感光層は、AS、Se原子の組成がAS: 0.1 ~45wt%、Se:55~99.9wt%の範囲内にあり、 感光層は単層でも複数層でも僻わない。又、感

厚いほど顕著に表れる。

保護圏の膜厚は任意に設定できるが、 $1\sim 10$ μ m、好ましくは $2\sim 7$ μ m である。

専習性支持体としては複電体あるいは導電処理をした絶縁体が用いられる。たとえばAI、Ni、Fe、Cu、Auなどの金属あるいは合金、ポリエステル、ポリカーポネート、ポリイミド、ガラス等の絶縁性基体上にAI、Ag、Au等の金属あるいはIn2O₃、SnOz等の導電材料の確膜を形成したもの、専電処理をした紙等が例示できる。

また導電性支持体の形状は特に制約はなく必要に応じて板状、ドラム状、ベルト状のものが 用いられる。

つぎに実施例並びに比較例について述べる。 実施例1

A ! 板上にA S 2 S C 3 蔑發膜を60 µ の厚さに設けて感光圏を形成した。これを電子写真特性評価機(川口電機製、Ś P - 428 型評価機)にて、正帯電にて帯電鉄光したところ、帯電圏

位1028 V、暗時20秒後の電位 240 Vになった。

この感光図上に、メチルシリルイソシアネート10壁量部とテトラシリルイソシアネート10館 図部と酢酸プチル80製量部の混合液を浸漉 塗 布して、25℃、60%RHにて2時間乾燥し、約 2000 Åの中間間を設けた。さらにこの上に、パリエステル樹脂(V-200、取洋紡製)10壁最初 と酸化スズ粉末(酸化アンチモン10wt%含有。 三菱金属製) 6選星部とジクロルエタン90重 部を48時間ポールミル分散して得た分散液を設 布乾燥して、5μの保護圏を設けて感光体とした。

この感光体は帯電階位1832 V、暗時20秒の電位1132 Vとなり、高い電荷保持特性を示した。 感度は 800 Vから80 Vまでの露光量として、

1.60 lx・sec になり、高感度を示し、残留電位は20Vであった。

実施例2

実施例1と同様に感光層を得た後、ビニルシリルイソシアネート 7重量部とテトラシリルイ

のない鮮明なコピーが常に得られた。 比較例1

実施例 1 において中間圏を取けることなく、 他は個様にして感光体を得た。この静電特性は、 帯電電位 18.6 V となり、ほとんど帯電せず実質 的な感度が得られなかった。

寒顺例4

アルミニウム素質(80 Φ× 340 L)に前処理 (洗浄)を施した後、其空蒸着装置内にセット し、AS2 Se3合金を支持体上の膜厚が60 μmとなる様に下記条件で抵抗加熱蒸着を行い 光導電陽を作製した。

蒸着条件:

真空度 3×10-6 Torr

支持体温度 200℃

ポート温度 450℃

次にこの光母電腦上に下記に示す条件で作製 した中間圏形成液を塗布し、空内放置乾燥を行い、 0.2 μm の膜厚を持つ中間圏を作製した。 中間層形成液: ソシアネート10担任部を、酢酸プチル83担重部 の混合物を感光層上に浸漬塗布し、25℃、60% R II にて 2 時間乾燥して2500 x の中間層を設け た以外、実施例 1 と国様の曝光体を得た。

この感光体の排電箱位も1500V、暗時20秒後の排電電位 980Vであった。 800Vから80Vまでの感度は 1.08 lx・sec 、残留電位は12Vになり、優れた特性を示した。

实施例3

A I シリンダーに60 4 厚のA S 2 S € 1 競行 膜を形成した。この上に実施例 1 と 回 様の中間 間を設けた。さらにこの上にスチロールアクリル酸ーアクリル酸ーNーメチロールアクリルアミド樹脂破(固形分 40 年最部と酸化アンチモン10 wt % 含有酸化スズ切 末 10 重 盤部と 変当 鏡の 辞 域を加え、ポールミルにて 72 時間分 版した分散液を浸過 塗布し 120 ℃で 30 分 乾燥い 保護 固が弱阈することなく、中ズ等による 画像 異常

メチルシリルトリイソシアネート

CH」SI(NCO)」 2重量が

テトライソシアネートシラン

SI(NCO) 4 6重量部

酢酸ηプチル

72组量部

更にこの中間図上に下記に示す様に抵抗制御剤を添加したポリオール硬化型ウレタン樹脂の保護圏形成液を120時間ボールミルにて分散した分散液を塗布し、120℃1時間で乾燥を行い、5μmの表面保護層を形成し感光体Aとした

抵抗制即削SnO₂做粉末(三菱金属製)

15重量部

ポリオール硬化型ウレタン樹脂

53座風部

ヘキサメチレンジィソシアネート

1重量部

メチルエチルケトン

46型册部

L MA (D) O

比较例2

実施例と全く間様な方法で光導電圏を形成した上に、下記に示す条件で作製した中間層形成被を塗布し、 100℃ 2 時間で乾燥し 0.2 μm の 脱門を持つ中間層を形成した。

中間簡形成被:

ジルコニウムアセチルアセトネート 2**2**0 ① 部

アーメタアクリロキシプロピル トリメトキシシラン

(信越化学製KBM503) 1型直部 n-ブタノール 40型回部

更にこの中間層の上に実施例と全く同様な方法で低抵抗保護層を形成し感光体Bとした。

上記の様にして得た本発明品感光体Aと比較 品感光体Bについて、放電電圧 6K V、露光量 11.5 μ W/cm² (光源はタングステンランプを使 们)の条件で、帯電、露光を行い、表面電位が 1000 V から 200 V に光級変する感度(μ J/cm²) を求め比較した。

表1に示すとおり、木発明局磁光体Aは比較

品感光休日に比べ落じるしく高感度であった。 更に木発明品の感光休Aについて複写枚数 30万枚の耐久試験を行った結果、異常画像は 全く認められず、初期と同様に良好な画像特性 であった。

[劝 果]

本発明は機械的寿命の長い高耐久性の感光体であり、又、残留電位の低い、くり返しコピーによる残留電位上昇のない優れた特性を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明の個傾成を示す説明図である。

1···透明保護層、 2···中國層、 3···光導電層、 4···導電性支持体。

水 1 図

